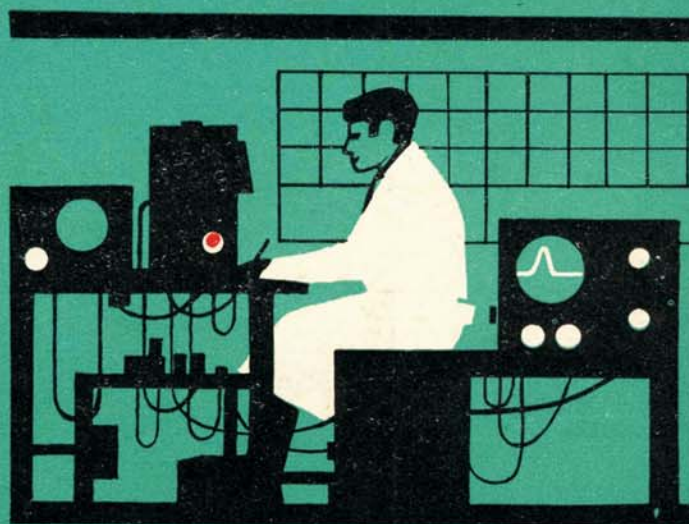
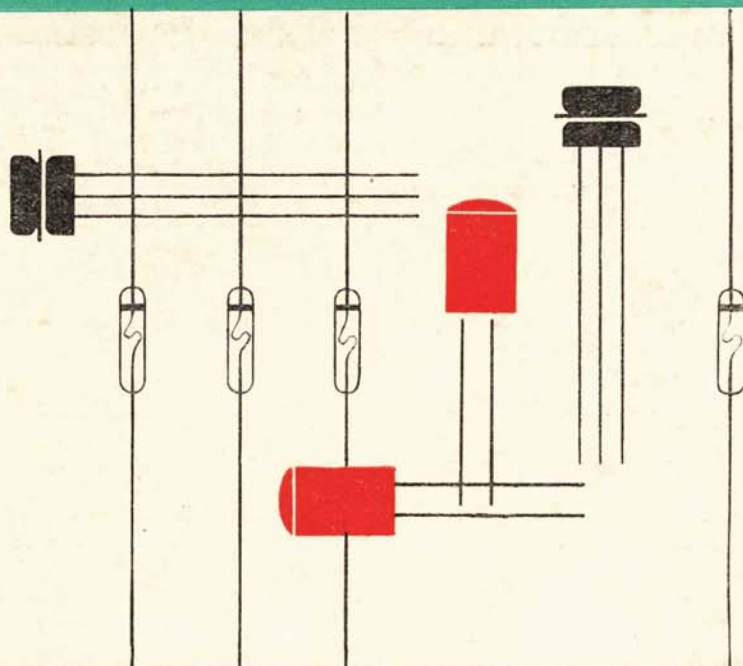



RFT


# Halbleiter- Bauelemente



Germaniumdioden


Type	Durchlaßspannung $U_{AK}$ [V]	Durchlaßstrom $I_{AK}$ [mA]	Sperrspannung $U_{KA}$ [V]	Sperrstrom $I_{KA}$ [ $\mu$ A]	max. zuläss. Sperrspannung $U_{KAmax}$ [V]	max. zuläss. Durchlaßstrom $I_{AKmax}$ [mA]	Bauform	Verwendungszweck									
bei $t_a = 25^0$ C - 5 grd																	
 Universaldioden	OA 625	1	≡ 5	10 20	≡ 100 ≡ 500	20 <sup>3)</sup>	20 4 <sup>2)</sup>	Universaldiode mit niederohmigem Durchlaßwiderstand									
	OA 645	1	≡ 3	10 40	≡ 100 ≡ 500	40 35 <sup>2)</sup>	15 3 <sup>2)</sup>	Universaldiode									
	OA 665	1	≡ 3	10 60	≡ 50 ≡ 500	60 50 <sup>2)</sup>	12 2,5 <sup>2)</sup>	1 Universaldiode									
	OA 685	1	≡ 2	10 80	≡ 50 ≡ 500	80 65 <sup>2)</sup>	10 2 <sup>2)</sup>	Universaldiode mit hochohmigem Sperrwiderstand									
	OA 705	1	≡ 2	10 100	≡ 15 ≡ 250	100 80 <sup>2)</sup>	10 2 <sup>2)</sup>	Universaldiode mit hochohmigem Sperrwiderstand									
	Videodioden	OA 626	1	≡ 3	10 20	≡ 100 ≡ 500	20 <sup>3)</sup>	20 4 <sup>2)</sup>	1 Zur Gleichrichtung der Bildzwischenfrequenz								
Diodenpaare	OAA 646 <sup>4)</sup>	1	≡ 5	10 40	≡ 100 ≡ 500	40 35 <sup>2)</sup>	10 2 <sup>2)</sup>	1 Radiodetektor									
	2OA 646 <sup>4)</sup>	1	≡ 5	10 40	≡ 40 ≡ 300	40 35 <sup>2)</sup>	15 3 <sup>2)</sup>	1 Radiodetektor									
Diodenquartett	O4A 657	1	7,5 . . . 12,5	10 40	≡ 40 ≡ 300	40 35 <sup>3)</sup>	15 3 <sup>2)</sup>	4 Zum Modulieren der Trägerfrequenz mit Trägerunterdrückung									
Richtdioden	OA 601 <sup>1)</sup>	1	≡ 5	5	≡ 1000	5	15	für dm-Wellenbereich <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Richtstrom I [mA]</td> <td rowspan="2">bei 50 mW HF-Leistung</td> <td rowspan="5" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">und f = 3 GHz</td> </tr> <tr> <td>≡ 4,5</td> </tr> <tr> <td>≡ 3,5</td> <td rowspan="2">bei 200 mW HF-Leistung</td> </tr> <tr> <td>≡ 7</td> </tr> <tr> <td>≡ 4,5</td> </tr> <tr> <td>≡ 4,5</td> </tr> </table>	Richtstrom I [mA]	bei 50 mW HF-Leistung	und f = 3 GHz	≡ 4,5	≡ 3,5	bei 200 mW HF-Leistung	≡ 7	≡ 4,5	≡ 4,5
Richtstrom I [mA]	bei 50 mW HF-Leistung	und f = 3 GHz															
≡ 4,5																	
≡ 3,5	bei 200 mW HF-Leistung																
≡ 7																	
≡ 4,5																	
≡ 4,5																	
	OA 602 <sup>1)</sup>	1	≡ 5	5	≡ 1000	5	15										
	OA 603 <sup>1)</sup>	1	≡ 5	10	≡ 1000	10	20										
	OA 604 <sup>1)</sup>	1	≡ 5	10	≡ 1000	10	20										
	OA 605 <sup>1)</sup>	1	≡ 5	20	≡ 1000	20	20										
Schaltdioden	OA 647	1	≡ 6	10 40	≡ 40 ≡ 1000	25	50	1 Schaltdioden mit geringer Sperrträgheit									
	OA 666	1	≡ 5	10 20 60	≡ 8 ≡ 10 ≡ 70	60 <sup>3)</sup>	150	1									
	OA 720	≡ 1	75	20	≡ 1000	20	50	1 Golddrahtdioden mit großem Verhältnis von Sperr- zu Durchlaßwiderstand									
	OA 721	≡ 0,7	75	20	≡ 1000	20	75	1									
	OA 722	≡ 0,75	100	5	≡ 20	20	120	2 Kleinflächendioden mit hohem Sperr- und kleinem Durchlaßwiderstand									
	OA 723	≡ 0,85	100	60	≡ 10	80	150	2									
	OA 741	≡ 0,8	75	10 40	≡ 50 ≡ 500	40	75	1 Golddrahtdioden mit großem Verhältnis von Sperr- zu Durchlaßwiderstand									
	OA 780	≡ 1	75	10 80	≡ 50 ≡ 250	80	50	1									

Siliziumdioden

Type	Durchlaßspannung $U_{AK}$ [V]	Durchlaßstrom $I_{AK}$ [mA]	Sperrspannung $U_{KA}$ [V]	Sperrstrom $I_{KA}$ [ $\mu$ A]	max. zuläss. Sperrspannung $U_{KAmax}$ [V]	max. zuläss. Verlustleistung $P_{vmax}$ [mW]	Bauform	Verwendungszweck
bei $t_a = 25^{\circ}C - 5$ grad								
								
OA 900 <sup>1)</sup>	1	$\cong 50$	$\cong 25$ 10	$\cong 100$ 0,1		250	2	Silizium-Flächendioden mit hohem Sperrwiderstand
OA 901 <sup>1)</sup>	1	$\cong 50$	$\cong 50$ 10	$\cong 100$ 0,1		250		
OA 902 <sup>1)</sup>	1	$\cong 40$	$\cong 75$ 10	$\cong 100$ 0,1		250		
OA 903 <sup>1)</sup>	1	$\cong 40$	$\cong 150$ 10	$\cong 100$ 0,1		250		
Zenerdioden	Zenerspannung $U_Z$ [V]	Zenerstrom $I_Z$ [mA]			Zenerwiderstand $r_Z$ [ $\Omega$ ] bei $I_Z = 3$ mA		2	Zur Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen, Begrenzung von Wechselspannungen und als Ueberspannungsschutz
ZA 250/5 <sup>1)</sup>	4,4 . . . 5,6	3	1	$\cong 0,1$	$\cong 150$	250		
ZA 250/6 <sup>1)</sup>	5,4 . . . 6,6	3	1	$\cong 0,1$	$\cong 110$	250		
ZA 250/7 <sup>1)</sup>	6,4 . . . 7,6	3	1	$\cong 0,1$	$\cong 25$	250		
ZA 250/8 <sup>1)</sup>	7,4 . . . 8,6	3	1	$\cong 0,1$	$\cong 30$	250		
ZA 250/9 <sup>1)</sup>	8,4 . . . 9,6	3	1	$\cong 0,1$	$\cong 35$	250		

Dioden

Leistungszenerdioden


Typ	Zenerspannung $U_Z$ [V]	Durchlaßstrom $I_{AK}$ [mA]	Zenerstrom $I_Z$ [mA]	Zener-Widerstand $r_Z$ [ $\Omega$ ] bei $I_Z = 10$ mA	$P_{max}$ [45 <sup>o</sup> C] ohne Wärmeableitung	Temperaturbereich $t_a$ [ <sup>o</sup> C]	Bauform	Verwendungszweck
								
ZL 910/6 <sup>1)</sup>	5,8— 7,2	500	10	< 20	1 W	- 55	8	Für Stabilisierungs- und Begrenzerschaltungen
ZL 910/8 <sup>1)</sup>	6,8— 9,2	500	10	< 12	1 W	bis		
ZL 910/10 <sup>1)</sup>	8,8—11,2	500	10	< 15	1 W	+ 150		
ZL 910/12 <sup>1)</sup>	10,8—13,2	500	10	< 20	1 W			
ZL 910/14 <sup>1)</sup>	12,8—15,2	500	10	< 30	1 W			
ZL 910/16 <sup>1)</sup>	14,8—17,2	500	10	< 40	1 W			

1) in Entwicklung befindlich


2) bei  $t_a = 60^{\circ}C$

3) bei  $t_a = 25^{\circ}C$  sowie  $60^{\circ}C$

4) Strom- und Spannungswerte der Einzeldiode


Typ	Kenn- und Grenzwerte bei $t_a = 25^{\circ} \text{C}$						Bauform	Verwendungszweck
	Sperrspannung $U_{KA}$ [V]	Sperrstrom $I_{KA}$ [mA]	Durchlaßstrom $I_{AK}$ [A]	Durchlaßspannung $U_{AK}$ [V]	Spitzenstrom $I_{akmax}$ [A]	$t_{amax}$ [ $^{\circ}\text{C}$ ]		
		( $25^{\circ} \text{C}$ )						
OY 100	20	$\leq 0,1$	0,1	0,5	0,35	60	5	Gleichrichter für kleine Ströme
OY 101	50	$\leq 0,1$	0,1	0,5	0,35	60		
OY 102	100	$\leq 0,1$	0,1	0,5	0,35	60		
		( $25^{\circ} \text{C}$ )						
OY 110	20	$\leq 0,1$	1	1	3	60	6	Gleichrichter für mittlere Ströme
OY 111	50	$\leq 0,1$	1	1	3	60		
OY 112	100	$\leq 0,1$	1	1	3	60		
OY 113	150	$\leq 0,1$	1	1	3	60		
OY 114	200	$\leq 0,1$	1	1	3	60		
		( $25^{\circ} \text{C}$ )						
OY 120	20	$\leq 1$	10	0,6	32	35	7	Gleichrichter für hohe Ströme
OY 121	40	$\leq 1$	10	0,6	32	35		
OY 122	65	$\leq 1$	10	0,6	32	35		
OY 123	100	$\leq 1$	10	0,6	32	35		
OY 124	150	$\leq 1$	10	0,6	32	35		
OY 125	200	$\leq 1$	10	0,6	32	35		

Silizium-Leistungsgleichrichter


		( $115^{\circ} \text{C}$ )						
OY 910 <sup>1)</sup>	50	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100	8	Gleichrichter mit erweitertem Temperaturanwendungsbereich
OY 911 <sup>1)</sup>	100	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		
OY 912 <sup>1)</sup>	200	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		
OY 913 <sup>1)</sup>	300	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		
OY 914 <sup>1)</sup>	400	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		
OY 915 <sup>1)</sup>	500	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		
OY 916 <sup>1)</sup>	600	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		
OY 917 <sup>1)</sup>	700	$\leq 0,5$	1	1,2	5	100		

<sup>1)</sup> in Entwicklung befindlich


Eine neue Typenreihe 1 A-Siliziumgleichrichter OY 9110 – OY 9180 befindet sich in Vorbereitung

Typ	Kennwerte bei $t_a = 25^{\circ}C$				Grenzwerte:				Bauform	Verwendungszweck
	Stromverstärkung $h_{21e}; \bar{\beta}$	Kollektorreststrom $-I_{CEO} [mA]$	Rauschfaktor $F [dB]$	Restspannung $-U_{CEO} [V]$	Kollektorspannung $-U_{CEmax} [V]$	Kollektorstrom $-I_{Cmax} [mA]$	Verlustleistung $P_{max} [mW]$	$t_{jmax} [^{\circ}C]$		
										
OC 815	10–20	< 800	< 25	< 0,3	15	50	50	75	9	NF-Endstufen kleiner Leistung
OC 816	> 20	< 800	< 25	< 0,3	15	50	50	75	9	
OC 817	> 20	< 800	< 10	—	15	50	50	75	9	Rauscharme NF-Vorstufen
OC 818	> 20	< 800	< 5	—	15	50	50	75	9	
OC 820	$\bar{\beta} > 10$	< 800	< 25	< 0,5	20	135	100	75	10	NF-Endstufen mittlerer Leistung
OC 821	$\bar{\beta} > 20$	< 800	< 25	< 0,5	20	135	100	75	10	
OC 822	$\bar{\beta} > 20$	< 800	—	< 0,5	30	135	100	75	10	30-V-Schalttransistor
OC 823	$\bar{\beta} > 20$	< 800	—	< 0,5	60	135	100	75	10	60-V-Schalttransistor
OC 824	10–40	< 800	< 25	—	20	135	120	75	11	NF-Endstufen mittlerer Leistung
OC 825	> 20	< 800	< 25	< 0,55	20	135	120	75	11	
OC 826	> 20	< 800	< 10	—	20	135	120	75	11	Rauscharme NF-Vorstufen
OC 827	> 20	< 800	< 5	—	20	135	120	75	11	
OC 828	$\bar{\beta} > 15$	< 800	—	< 0,55	33	135	120	75	11	30-V-Schalttransistor
OC 829	$\bar{\beta} > 15$	< 800	—	< 0,55	66	135	120	75	11	60-V-Schalttransistor

Germanium-Leistungstransistoren


Typ	$-I_B [mA]$ für $-I_C = 100 mA$	$-I_{CEO} [mA]$	$-I_{CBO} [mA]$	$-U_{CEO} [V]$	$-U_{CEmax} [V]$	$-I_{Cmax} [A]$	$P_{max} [W]$	$t_{jmax} [^{\circ}C]$	Bauform	Verwendungszweck
										
OC 830	$\leq 10$	< 1	< 30	< 1	20	1	1	75	12	NF-Leistungs-Endstufen
OC 831	$\leq 5$	< 1	< 30	< 1	20	1	1	75		
OC 832	$\leq 5$	< 1	< 30	< 1	30	1	1	75		30-V-Schalttransistor
OC 833	$\leq 5$	< 1	< 30	< 1	60	1	1	75		60-V-Schalttransistor
	$-I_B [mA]$ für $-I_C = 200 mA$			$-U_{CES} [V]$						
OC 835	$\leq 20$	< 1,5	< 50	0,6	20	3	4	75	12	NF-Leistungs-Endstufen
OC 836	$\leq 10$	< 1,5	< 50	0,6	20	3	4	75		
OC 837	$\leq 10$	< 1,5	< 50	0,6	30	3	4	75		30-V-Schalttransistor
OC 838	$\leq 10$	< 1,5	< 50	0,6	60	3	4	75		60-V-Schalttransistor

Germanium-Hochfrequenz-Transistoren

Typ	Kennwerte bei $t_a = 25^\circ\text{C}$						Grenzwerte		Bauform	Verwendungszweck	
	$Y_{21e}$ [mA/V] bei:			$r_{Bb}$ [ $\Omega$ ]	$f_{\alpha}$	$f_{\beta=1}$	Reststrom $-I_{CEO}$ [ $\mu\text{A}$ ]	$P_{max}$ [mW]			$t_{jmax}$ [ $^\circ\text{C}$ ]
	$-U_{CE}=6\text{V}$	$-U_{CE}=6\text{V}$	$-U_{CE}=6\text{V}$		$-U_{CE}=6\text{V}$						
	$-I_C=0,5\text{mA}$ $f=500\text{KHz}$	$-I_C=0,5\text{mA}$ $f=2\text{MHz}$	$-I_C=1\text{mA}$ $f=10\text{MHz}$		$-I_C=0,5\text{mA}$ [MHz]	$1\text{mA}$ [MHz]					
	$h_{21e} > 20$ für $-U_{CE}=6\text{V}$ , $-I_C=2\text{mA}$			—	$> 1$	—	$< 800$	30	75	13	NF-Transistor für Vorstufen
OC 870	$> 13$	—	—	$< 300$	$> 3$	—	$< 800$	30	75	13	ZF-Stufen 450 KHz
OC 871	—	$> 10$	—	$< 350$	$> 7$	—	$< 800$	30	75	13	Mischstufen 2 MHz
OC 872	$h_{21e} > 50$ für $-U_{CE}=6\text{V}$ , $-I_C=2\text{mA}$			$< 300$	7–10	—	$< 800$	30	75	13	Breitbandverstärker in der TF-Technik
OC 873 <sup>1)</sup>	$\beta > 50$ für $-U_{CE}=1\text{V}$ , $-I_C=10\text{mA}$			—	—	—	$< 800$	30	75	13	Für Schalteranwendungen mittlerer Geschwindigkeit
OC 874 <sup>1)</sup>	—	$> 10$	—	$< 300$	$> 10$	—	$< 500$	50	75	11	Mischstufen 2 MHz
OC 880 <sup>1)</sup>	—	—	$> 20$	$< 200$	—	$> 20$	$< 500$	50	75		Vor- und Mischstufen im KW-Bereich
OC 881 <sup>1)</sup>	—	—	$> 26$	$< 100$	—	$> 30$	$< 500$	50	75		ZF-Stufen 10,7 MHz
OC 882 <sup>1)</sup>	—	—	$> 30$	$< 50$	—	$> 50$	$< 500$	50	75		Mischstufen bis 100 MHz
OC 883 <sup>1)</sup>	—	—	$> 30$	$< 50$	—	$> 50$	$< 500$	50	75		

<sup>1)</sup> in Entwicklung befindlich

Germanium-Flächentransistoren

Typ	Statische Werte		Dynamische Werte		Grenzwerte			Bauform	Verwendungszweck
	$I_{CBO}$ [ $\mu\text{A}$ ]	$I_{CEO}$ [ $\mu\text{A}$ ]	$f_{\alpha}$ [MHz]	$h_{21e}$	$P_{max}$ [mW]	$I_{Cmax}$ [mA]	$U_{CEmax}$ [V]		
									
LA 25	$\leq 30$	$\leq 1000$	$\geq 0,2$	10 . . . 80	25	15	10	9	NF-Transistor f. Vorstufen
LA 50	$\leq 30$	$\leq 1000$	$\geq 0,2$	10 . . . 80	50 . . 100	50	10	9	NF-Transistor
LA 100	$\leq 30$	$\leq 1500$	$\geq 0,2$	10 . . . 80	120 . . 150	150	—	11	NF-Transistor
LA 1	$\leq 50$	$\leq 2000$	—	—	1000	1000	—	12	NF-Leistungstransistor
LA 4	$\leq 100$	$\leq 4000$	—	—	4000	3000	—	12	NF-Leistungstransistor
LA 30	$\leq 30$	$\leq 1500$	$\geq 3,0$	20 . . . 100	30	15	—	13	HF-Transistor

Die Transistoren dieser Typenreihe eignen sich speziell für Lehr- und Amateurzwecke, können aber jederzeit auch in anspruchsvolleren Schaltungen eingesetzt werden. **Zu Sonderpreisen in Fachgeschäften erhältlich.**

Weitere Halbleiter-Bauelemente werden hergestellt:

Fotodioden vom VEB Carl Zeiss Jena

Halbleiter-Widerstände vom VEB Keramische Werke, Hermsdorf (Thür.)

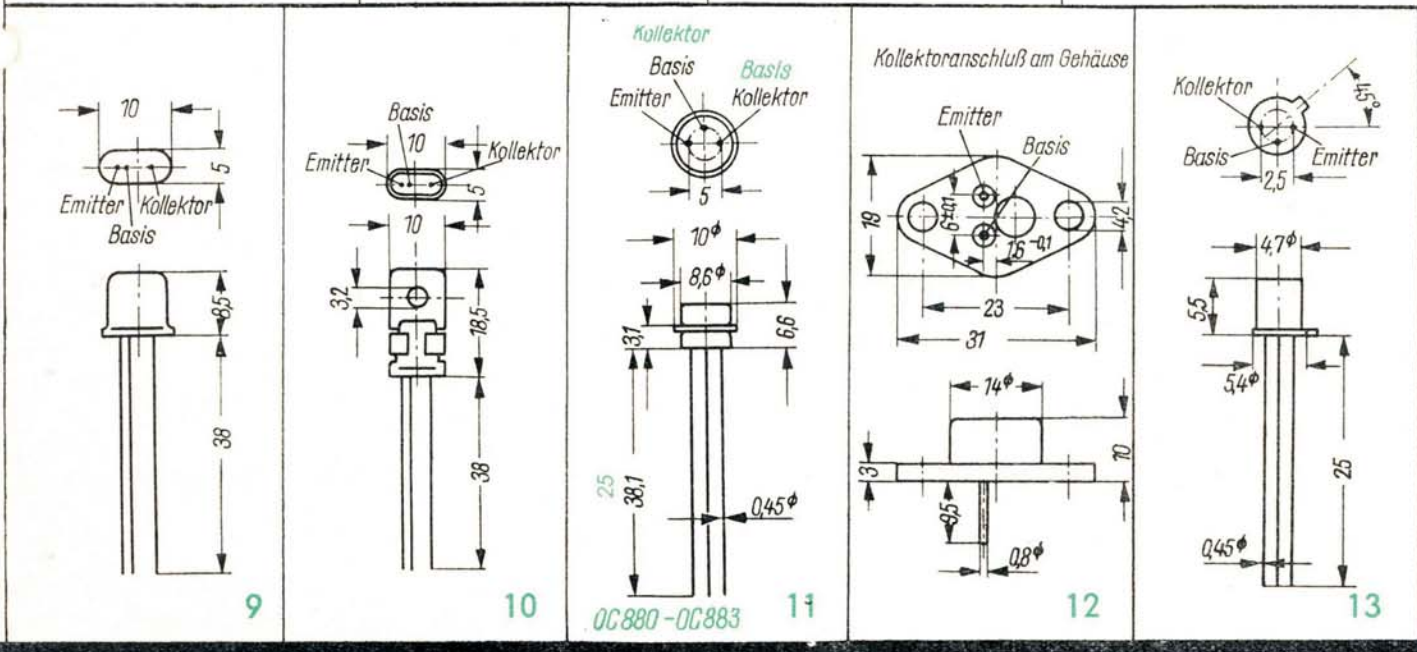
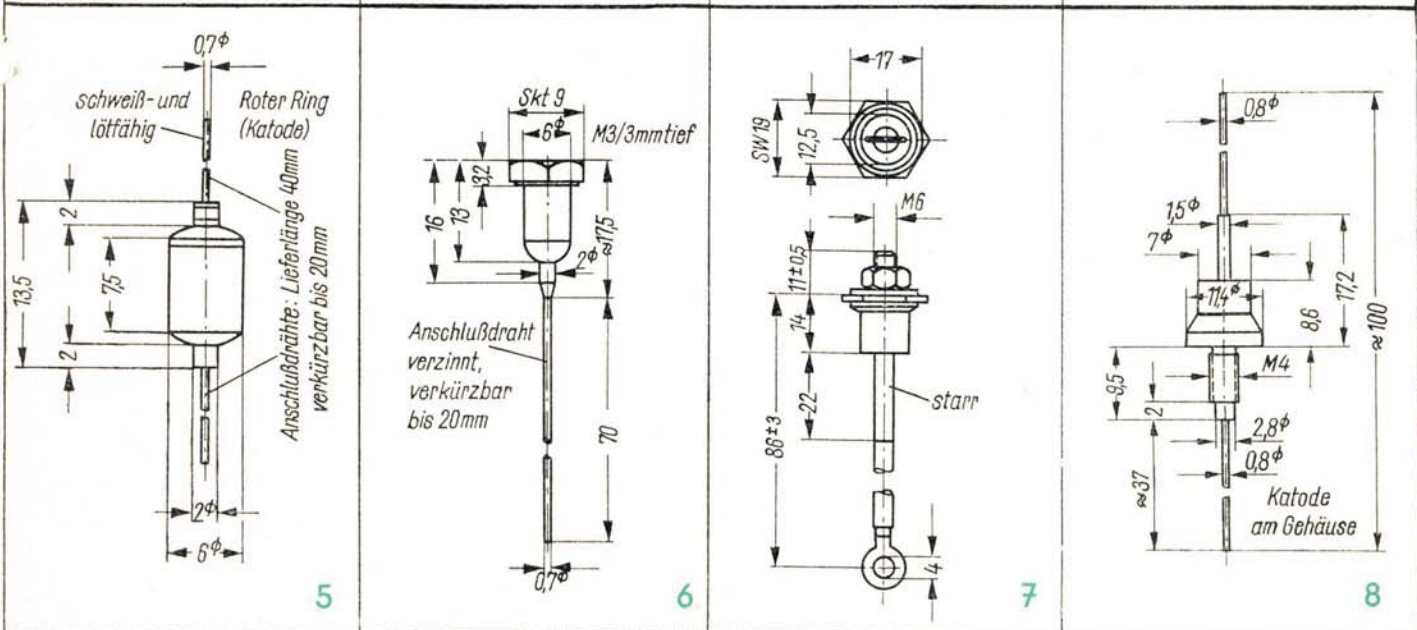
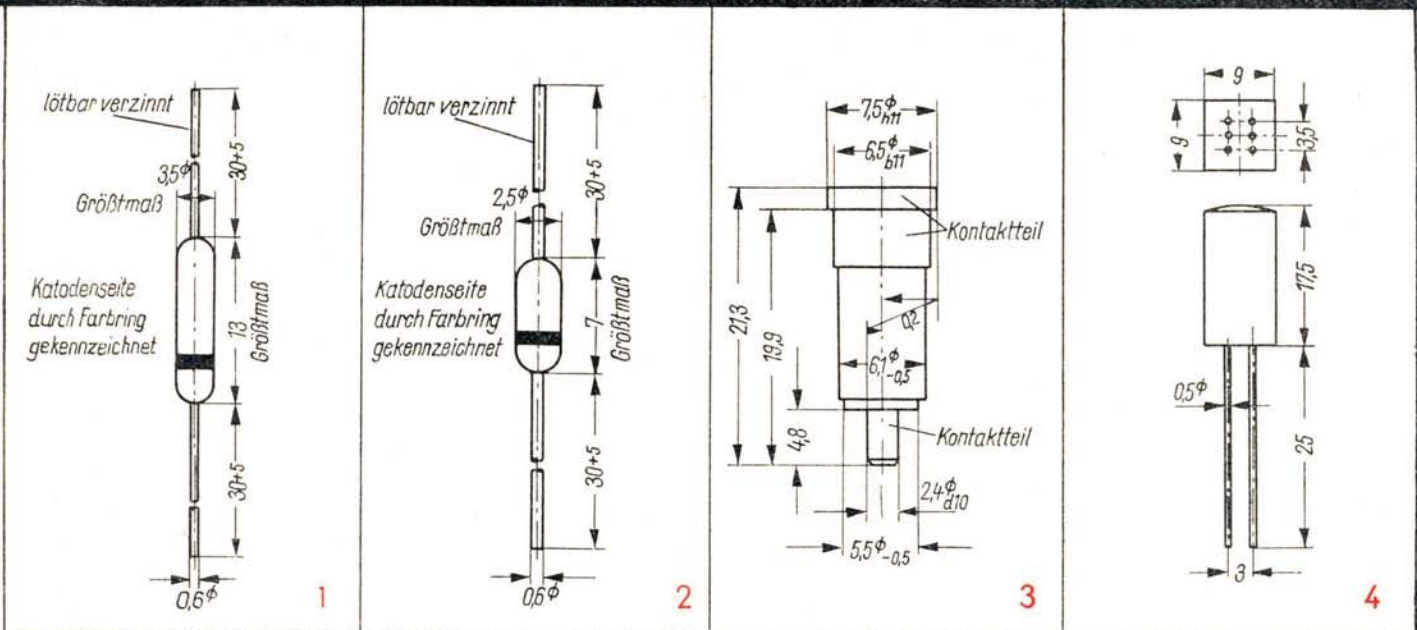
Änderungen vorbehalten!



VEB Werk für Fernsehelektronik



VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)



**Mindestbestellmenge für den Direktbezug:**

Je Planposition 1000 Stück im Sortiment,  
jedoch mindestens 100 Stück pro Type.  
Erzeugnisse aus Vorserie und Laborfertigung je  
Planposition 50 Stück.

**Auslieferungen von Mindermengen:**

Versorgungskontor für Maschinenbau-Erzeugnisse,  
Potsdam, Leipziger Straße 60

**Halbleiter-Bauelemente sind im einschlägigen Fachhandel erhältlich.**

Export-Information durch:

**Heim-Electric**

**Deutsche Export- und Importgesellschaft mbH.**

Berlin C 2, Liebknechtstraße 14



**VEB Werk für Fernsehelektronik**

Berlin-Oberschöneweide, Ostendstraße 1-5  
Fernruf 63 28 41 – Telegramm-Anschrift: Oberspreewerk – Fernschreiber: WF Berlin 011 470



**VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)**

Frankfurt (Oder) – Markendorf  
Fernruf-Sammelnummer 690 – Fernschreiber 016 252

**Ausgabe September 1962**